

## عنوان مقاله:

طراحی یک تقویت کننده عملیاتی با بهره ی بالا بر مبنای فیدبک مثبت در تکنولوژی ۰.۱۸ μm CMOS

## محل انتشار:

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر (سال: ۱۳۹۴)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۶

## نویسندگان:

جواد ایزدی - دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

بهروز حیدری - استاد راهنما و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

محمد باقر توکلی - استاد مشاور و رییس گروه الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

## خلاصه مقاله:

یک قسمت مهم در طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ طراحی و ساخت جریان ها ولتاژهای مرجع با مقادیر بخوبی تعریف شده می باشد برای اینکه این کار بر روی تراشه و به صورت مجتمع انجام می شود معمولا از مدارهای مرجعی استفاده می شود که مدارهای مرجع گاف انرژی نامیده می شود این مدارها نیاز به تقویت کننده های عملیاتی با بهره ی بالا دارند تا بتوانند تغییرات دمایی بسیار پایینی داشته باشند در این مقاله یک مدار جدید برای تقویت کننده ی عملیاتی پیشنهاد و ارائه می گردد

## کلمات کلیدی:

مدار مرجع ولتاژ، ناحیه ی زیر آستانه، تغییرات دمایی، مصرف توان پایین

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/۴۸۰۰۱۸/>